

КТ503Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Область применения: усилители низкой частоты, операционные и дифференциальные усилители, преобразователи, импульсные устройства.

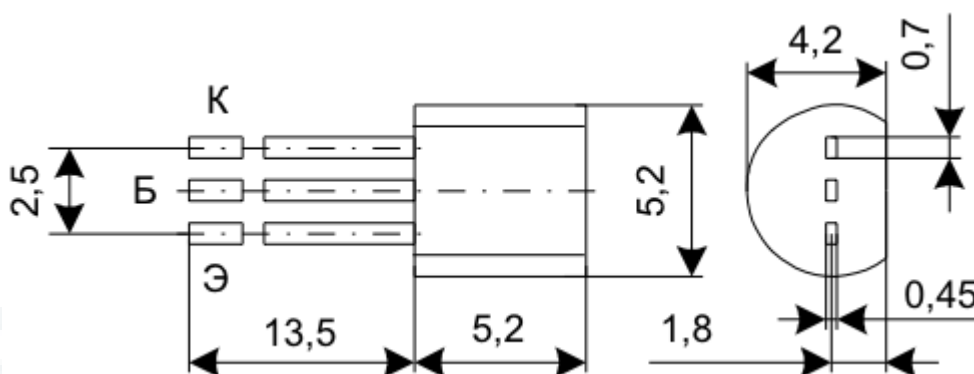
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Тип корпуса: КТ-26 (ТО92).

Технические условия: аА0.336.183 ТУ/02.



Основные технические характеристики транзистора КТ503Г:

- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 350 мВт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 5 МГц;
- $U_{кб\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В;
- $U_{эб\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_{к(и)\max}$ - Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора: 15 (35) мА;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб}=60$ В : не более 1 мкА;
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером: 80...240;
- S_k - Емкость коллекторного перехода: не более 20 пФ.